



<http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=dfd976d2-8bed-4968-a2be-20caf171e136&print=1>

© 2025 Российская академия наук

№ 400 от 26.12.2006

Российская академия наук

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**О присвоении имени академика А.В.Ржанова Институту физики полупроводников СО РАН
(представление Сибирского отделения и Отделения информационных технологий и
вычислительных систем)**

В целях увековечения памяти выдающегося ученого в области физики твердого тела, физики полупроводников и физических основ полупроводниковых интегральных схем микроэлектроники и микрофотоэлектроники академика Анатолия Васильевича Ржанова, заместителя председателя СО РАН, члена Президиума СО РАН, организатора и первого директора Института физики полупроводников СО РАН (1962-1990 гг.) Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить Институту физики полупроводников Сибирского отделения РАН имя академика А.В.Ржанова и впредь именовать его - Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Сибирское отделение и Отделение информационных технологий и вычислительных систем РАН.

И.о. президента Российской академии наук
академик А.Д.Некипелов

Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук
академик В.В.Костюк